DEST AVAILABLE COPY

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



1 COLO DE COLO DE COLO DE LA COLO DE LA COLO DE COLO D

(43) 国際公開日 2005年5月19日 (19.05.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/045907 A1

(51) 国際特許分類":

H01L 21/02

PCT/JP2004/015835

(21) 国際出願番号: (22) 国際出願日:

2004年10月26日(26.10.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

日本語

(26) 国際公開の書語:

(30) 優先権データ: 特額 2003-379981

2003年11月10日(10.11.2003)

(71) 出願人 (米国を除く全ての招定国について): 株式会 社ルネサステクノロジ (RENESAS TECHNOLOGY CORP.) [JP/JP]; 〒1006334 東京都千代田区丸の内二 丁目 4 番 1 号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

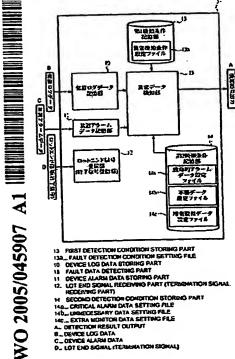
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 所附 一之 (TOKO-ROZUKI, Kazuyuki) [JP/JP]; 〒1006334 東京都千代田 区丸の内二丁目 4番 1号 株式会社ルネサステクノロジ内 Tokyo (JP). 中島 理博 (NAKAJIMA, Toshihiro) [JP/JP]; 〒1006334 東京都千代田区丸の内二丁目4番 1号 株式会社ルネサステクノロジ内 Tokyo (JP). 宮本 佳幸 (MIYAMOTO, Yoshiyuki) [JP/JP]; 〒1006334 東 京都千代田区丸の内二丁目4番1号株式会社ルネサ ステクノロジ内 Tokyo (JP). 深山 吉生 (FUKAYAMA, Yoshio) [JP/JP]; 〒1006334 東京都千代田区丸の内二 丁目4番1号 株式会社ルネサステクノロジ内 Tokyo

(74) 代理人: 筒井 大和 (TSUTSUI, Yamato); 〒1600023 東 京都新宿区西新宿8丁目1番1号アゼリアビル3階 简并国際特許事務所 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: METHOD FOR MAKING SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT DEVICE

(54) 免明の名称: 半導体集積回路装置の製造方法



- 13 PREST DETECTION CONDITION STORMING PART
 132_FAULT OFFECTION CONDITION SETTING FUE
 10 DOVICE LOG DATA STORMING PART
 15 FAULT DATA DETECTING PART
 11 DOVICE ALARM BATA STORMING PART
 12. LOT END SOMML RECEIVEND PART (TERMINATION SIGNAL
 RECEIVENG PART)
- REJECTING PART)

 N SCOUND DETECTION CONDITION STORMS PART

 140... CRITICAL ALARM DATA SETTING FILE

 140... UNDECESSARY DATA SETTING FILE

 140... EXTRA MONTOR DATA SETTING FILE

 A... DETECTION RESULT OUTPUT

 RESIDENT DATA SETTING FILE

 RESIDENT DATA SETTI

- B. DEVICE LOG DATA
- C_DEVICE ALARM DATA
 D. LOT END SIGNAL ITERMINATION SIGNAL)

(57) Abstract: A method for making semiconductor integrated circuit devices, wherein a defective wafer that is out of spec can be detected in real time. A fault detection server (5) stores, in a device log data storing part (10), device log data outputted from a semiconductor making apparatus for processing semiconductor wafers. Thereafter, when a lot end signal receiving part (12) receives a lot end signal outputted from the semiconductor making apparatus, a fault data detecting part (15) refers to a fault detection condition setting file (13a) stored in a first detection condition storing part (13), and then determines, based on the content as referred to, whether there exist any fault data in the device log data stored in the device log data storing part (10). When detecting any fault, the fault data detecting part (15) outputs a detection result to an engineer PC or an operator terminal device.

規格外れの不良ウェハをリアルタイムに検出すること ができる半導体集積回路装置の製造方法を提供することにある。 異常検知サーバ5は半導体ウェハを処理する半導体製造装置か ら出力された装置ログデータを装置ログデータ記憶部10に記憶 する。その後、ロットエンド借号受信部12において、半導体製 造装置から出力されるロットエンド信号を受信すると、異常デ 夕検知部15は、第1検知条件記憶部13に記憶されている異常 検知条件設定ファイル13gを参照した後、参照した内容に基づいて装置ログデータ記憶部10に記憶されている装置ログデータ の中に異常データがあるか否かを料定する。そして、異常を検知 するとエンジニアPCや作業者端末装置に検知結果を出力する。

SEST AVAILABLE COP: